

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/136

(11)
(43)

2002 - 0054848
2002 07 08

(21)
(22)

10 - 2000 - 0084088
2000 12 28

(71)

20

(72)

282 - 2101 - 401

242 - 29

(74)

:

(54)

(,)

,

,

2a 2d

3a 3d

11 : 12a :

12b : 13 :

14 : 15 :

16, 17 : / 18 :

19a : 19b :

12c :

, .

,

,

.

가

,

.

(sputtering)

,

.

(ITO : Indium Tin Oxide)

(SnO₂)

ITO

가

가

(dot matrix)

ITO

(photo litho

ITO
graph)

가

, ITO

가

(photo resist)

(etching)

가

가가

1, TFT (Pad) , TFT (1)
 (2a) , (1)
 3) (4) (4) (3) (ohmic contact layer) (5)
 (6) (7) 가
 (7) (8) (7) 가
 (9a) (1) (2b) 가
 1 (2b) (2b) (8)
 (3) (2b)가 (9b)

1 (3) (8)
 (6), (7), (2a) (2b) (Cu), (Ti)
 (9a) (9b) ITO(Indium Tin Oxide)

, TFT (1)
 (Sputtering) TFT , P/R(Photo - Resist) ,
 (2a) , (2b)

, (2a) (SiNx), (SiOx) PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)
 (3) (4) (5) (2a) (5)
 (6) (7) (3) (4) (5)
 (6) (7) (8) TFT (7)
 (2b)가 (8) /

, ITO , TFT (7)
 (9a) (2b) (9b)

가 ITO(Indium Tin Oxide)
 (stripper)가 ITO(Indium Tin Oxide) (grain boundary)
 (Galvanic)
 (1 " 10")

2a 2d

2a , TFT (11) Cu, Cu/Ti Cu Cu/Ti가
 TFT (12a) (12b) (11) (12b)
 (12a) (12b) (11)
 (13)
 , 2b , TFT (13) (14), (15) /
 (16,17)
 2c , / (16,17) (13)
 (18) , (18) ()
 (17) (12b)가 (18a)
 2d , (18a)
 (17) (19a) (12b) (19
 b)

, (19a) (19b) ITO(Indium Tin Oxide) IZO(Indium
 Zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide)
 150~350

, 3a 3d

3a , TFT (11) Cu Cu/Ti Cu Cu/Ti가
 TFT (12a)
 , (12a) (11)
 (13)
 , 3b , TFT (13) (14), (15) /
 (16,17) , (13) (12c)
 3c , / (16,17) (12c)
 (18) , (18) ()
 (17) (12c)가 (18a)

3d (17) , (18a) (19a) (12c) , (19b)

, (19a) (19b) ITO(Indium Tin Oxide) IZO(Indium Zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide) .

ITO , IZO , ITZO ,

, 500 ~2000 가 . ITO

, 가 .

가 (stripper)

(57)

1.

2.

1 , H_2O 가- ITO

3.

1 , H_2 가- ITO

4.

1 , ITO

5.

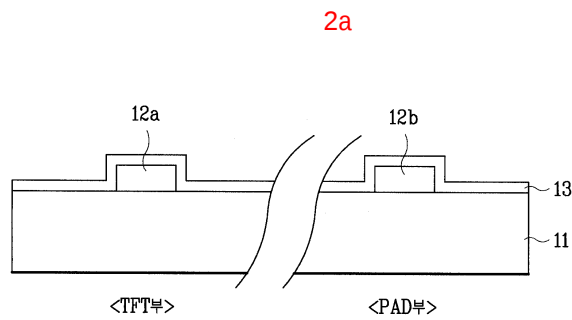
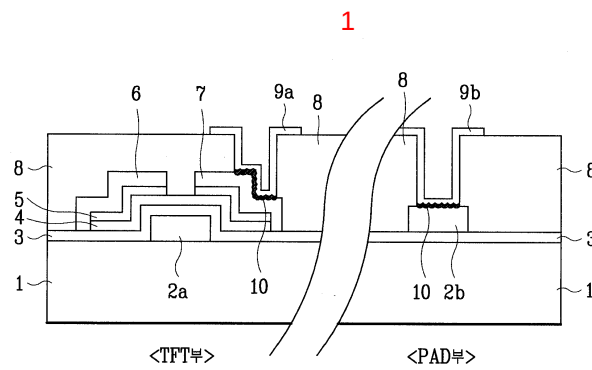
1 , IZO, ITZO

6.

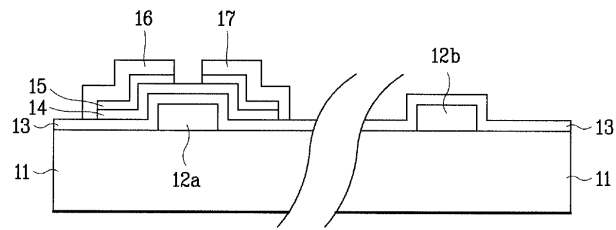
1, 150~350

7.

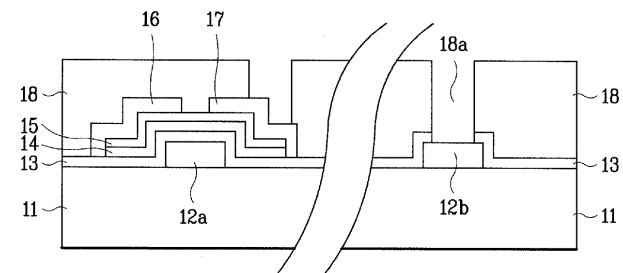
가 500 ~2000 ITO



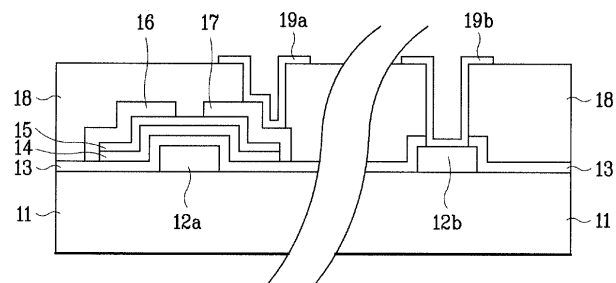
2b



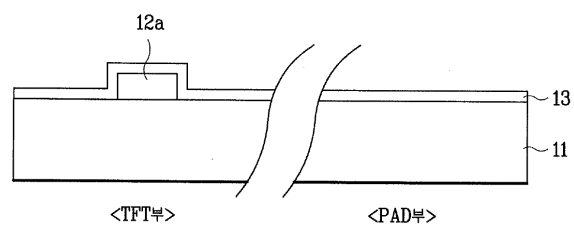
2c



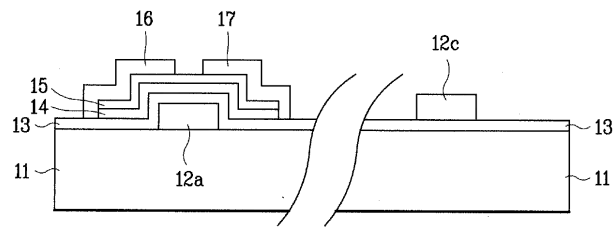
2d



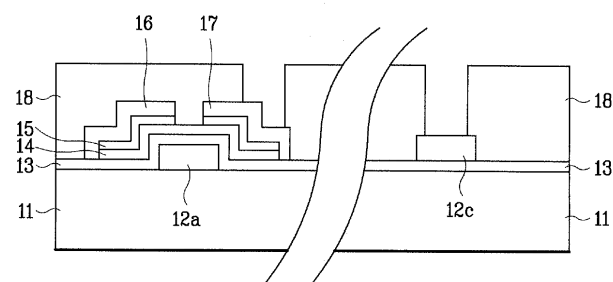
3a



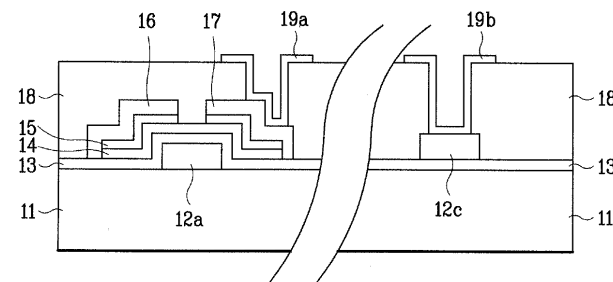
3b



3c



3d



专利名称(译)	液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020020054848A	公开(公告)日	2002-07-08
申请号	KR1020000084088	申请日	2000-12-28
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KWON OHNAM 권오남 KIM JONGIL 김종일		
发明人	권오남 김종일		
IPC分类号	G02F1/1362 G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/13458 G02F1/136227		
代理人(译)	金勇 新昌		
其他公开文献	KR100778835B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明，在包括台阶形成的基板的前面形成栅极绝缘层的步骤，以及包括栅极和栅极焊盘的栅极线的栅极电极，在栅极上形成半导体层的步骤栅电极上侧的绝缘层，具有固定在上述半导体层的二等分上侧的间隙的源电极和漏电极是形成包括数据焊盘以便定位的数据线的步骤，以及保护膜在基板的前部形成基板的前部，作为涉及液晶显示器制造方法的发明，提高了产量，焊盘部分的接触不良（栅极和数据）和透明导电膜被阻止。并且其特征在于包括形成接触孔的步骤，选择性地去除保护膜，使得漏电极，栅极焊盘和数据焊盘暴露，在基板的前面形成非晶透明导电膜的步骤包括每个接触孔，以及形成连接到像素电极的焊盘接触膜的步骤。形成连接到像素电极的焊盘接触膜的步骤选择性地去除非晶透明导电膜，并通过栅极焊盘和数据焊盘的接触孔连接到漏电极。像素电极和非晶透明导电电影。

